

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

マツカタ氏名の発明者として、私は以下通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、郵便局、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明大意について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名前が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE

上記発明の明細書（下記の欄でx記がついていない場合は、本書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

 一月一日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号を _____ とし、
(該当する場合) _____ に訂正されました。 was filed on December 24, 1997
as United States Application Number or
PCT International Application Number
08/997,919 and was amended on
_____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、運営規則在典第37編第1条56項に定義されるおり、特許資料の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第35編第119条(a)-(c)項又は365条(b)項に基いて、米国外の他の少なくとも一ヵ国を指定している特許協力条約365(a)項に基いて三段出願、又は外までの特許出願もしくは発明登録の出願について米国外優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明登録の外までの出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s)

外までの元特許出願

8-358974

Japan

(Number)
(番号)(Country)
(国名)(Number)
(番号)(Country)
(国名)

私は、第35編米国法典119条(e)項に基いて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)

私は、下記の米国法典第35編1120条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)に基いて権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で実行する米国特許出願に開示されていない限り、その実行米国出願書提出日以後で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条563項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書にて私が行なう声明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく声明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の声明及びそれと同様の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方ににより処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のことく宣言を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed

優先権主張なし

December 27, 1996

(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112. I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(三種宣言書)

著者：私は下記の発明者として、本発明に関する一切の
権利をもくろみを表示して正直である所を上記したて置く
こと。下記の権利を有することを、(元発明者たる所
での元もよび登録者を規定のこと)

Scott C. Eattis Reg. No. 32,030

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint
the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this
application and transact all business in the Patent and Trademark
Office connected therewith (list name and registration number);

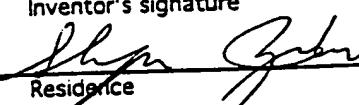
送信元
Scott C. Eattis
EISE & RICE ALEXON
4225 Executive Square, Ste. 1400
La Jolla, CA 92037

Send Correspondence to:

送信電話番号：(名前および電話番号)

Scott C. Eattis
(619) 678-5070

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

唯一または第一発明者		Full name of sole or first inventor	
		Shunpei YAMAZAKI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
			
住所	Residence	May 8, 1998	
		Tokyo, Japan	
国籍	Citizenship		
		Japanese	
私書箱	Post Office Address		
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan	
第二共同発明者		Full name of second joint inventor, if any	
		Jun KOYAMA	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
			
住所	Residence	May 8, 1998	
		Kanagawa, Japan	
国籍	Citizenship		
		Japanese	
私書箱	Post Office Address		
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan	

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をす
ること)

(Supply similar information and signature for third and
subsequent joint inventors.)

第三共同発明者		Full name of third joint inventor, if any	
		Hisashi OHTANI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Hisashi Ohtani May 8, 1998	
住所	Residence		
		Kanagawa, Japan	
国籍	Citizenship		
		Japanese	
私書箱	Post Office Address		
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan	
第四共同発明者		Full name of fourth joint inventor, if any	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		
第五共同発明者	Full name of fifth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		
第六共同発明者	Full name of sixth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		